

表1

	Si	4H-SiC	GaN	β -Ga ₂ O ₃	ダイヤモンド
バンドギャップ (eV)	1.1	3.3	3.4	4.9	5.5
絶縁破壊電界 (MV cm ⁻¹)	0.3	2.8	3.3	8	10
電子移動度 (cm ² V ⁻¹ s ⁻¹)	1500	1000	≥ 1200	200	≥ 1060
正孔移動度 (cm ² V ⁻¹ s ⁻¹)	450	120	< 200	-	≥ 2100
電子飽和速度 (10 ⁷ cm s ⁻¹)	1.1	1.9	2.5	2	2.5
正孔飽和速度 (10 ⁷ cm s ⁻¹)	0.8	1.2	-	-	1.4
比誘電率	11.8	9.7	9	10	5.7
熱伝導率 (W cm ⁻¹ K ⁻¹)	1.5	3.7	2.5	0.27	22